سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
طراحی و شبیه سازی یک نوع SOI Mosfet جهت بهبود پارامترDIBL

محل انتشار:
اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:
صمد قلندری - *کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه*

آرش احمدی - *استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه*

خلاصه مقاله:
در این مقاله یک ساختار جدید باری ترانزیستور FD SOI Mosfet به منظور بهبود پارامتر DIBL و همچنین بهبود اثر خودگرمایی ارائه شده است. ایده اصلی این ساختار تغییر در ضخامت لایه Box ترانزیستور که به منظور بهبود پارامتر DIBL و اثر خود گرمایی می باشد.

کلمات کلیدی:
اثر خود گرمایی، DIBL-FD SOI Mosfet

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/437506